

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W1XT452N</b>	文件编号	XS-R-329
	<b>瞬态电压抑制（双向 TVS）二极管</b>	版本号	18-A3-06
		页 码	1/3

## 1 主要用途与主要特点

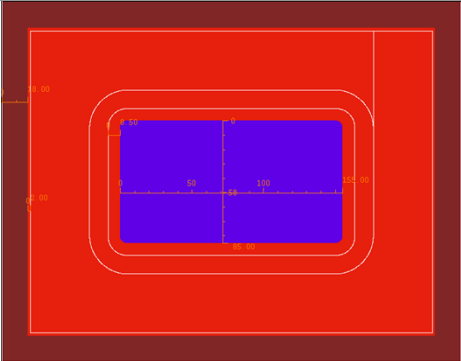
### 1.1 主要用途

用 W1XT452N 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。

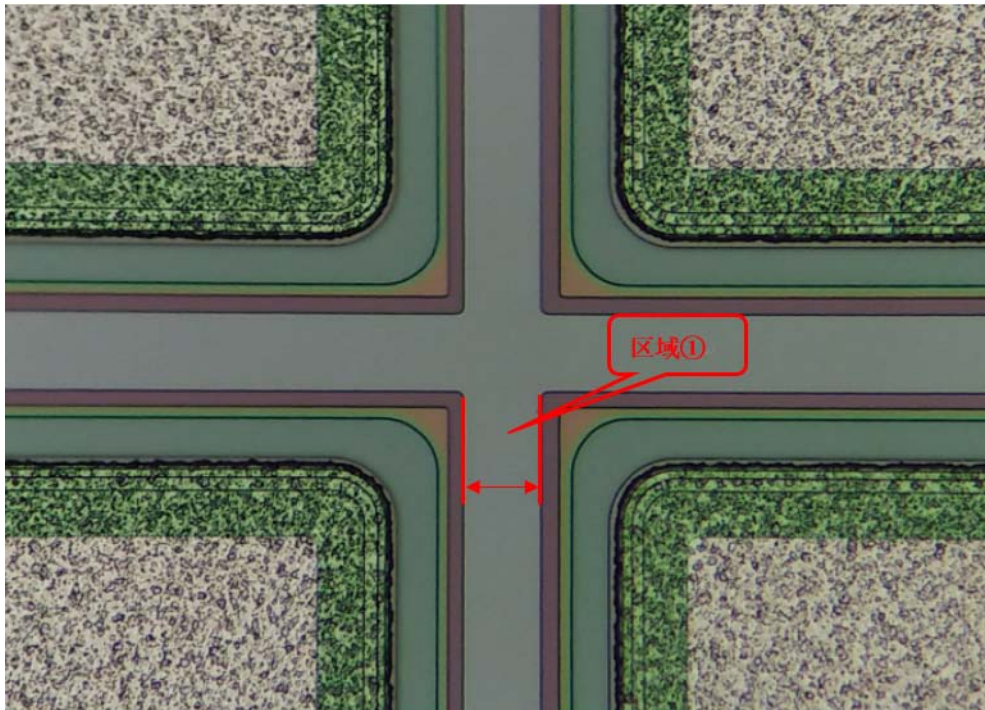
### 1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

## 2 芯片数据

	芯片尺寸 (mm×mm)		0.32×0.25	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170	
	划片道*尺寸 (μm)		50	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	正面	155×85	
		背面	155×85	
	正面电极	金属	铝	
		厚度	5.0±1.0	
	背面电极	表层金	银	金
	装片要求 (推荐)		低温共晶	共晶
	硅片直径 (mm)		φ 125	
键合要求 (推荐)		铜丝; φ 22 μm; 1 根		

\* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片道区域, 宽度为 50μm。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电 话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片  
W1XT452N

瞬态电压抑制 (TVS) 二极管

文件编号	XS-R-329
版本号	18-A3-06
页 码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

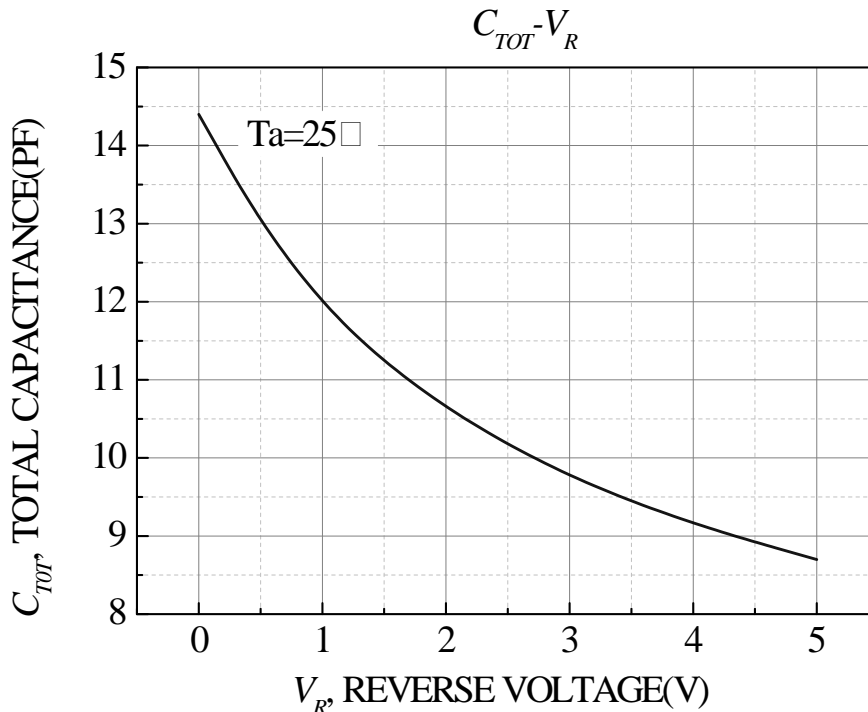
参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-523 推荐成品: CESDBLC5V0D5
贮存温度	$T_{stg}$	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	$V_{BR}$	$I_z = \pm 1\text{mA}$	5.5	7.2	8.5	V
反向电流	$I_R$	$V_R = \pm 5\text{V}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
结电容	$C_{tot}$	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	14.5	—	pF
反向峰值电压	$V_{C1}$	$I_P = \pm 5\text{A} (8 \times 20\mu\text{s})$	—	—	12.5	V
反向峰值电压	$V_{C2}$	$I_{PP} = \pm 8\text{A} (8 \times 20\mu\text{s})$	—	—	15	V

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电 话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)  
传真: (0510) 86851532



江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片  
W1XT452N

瞬态电压抑制 (TVS) 二极管

文件编号

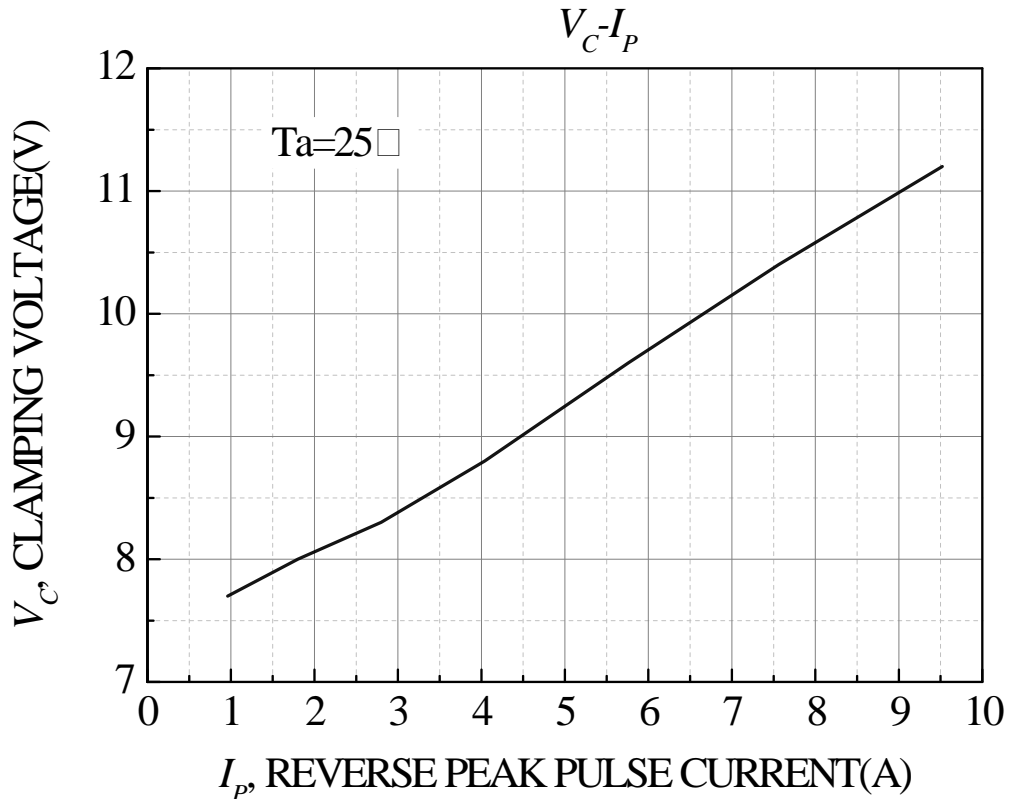
XS-R-329

版本号

18-A3-06

页码

3/3



注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度  $25\pm 5^\circ\text{C}$ , 湿度  $\leq 45\%$ ;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532